

大島商船高等専門学校	開講年度	令和03年度(2021年度)	授業科目	電子機器特論
科目基礎情報				
科目番号	0055	科目区分	専門 / 選択	
授業形態	授業	単位の種別と単位数	学修単位: 2	
開設学科	海洋交通システム学専攻	対象学年	専1	
開設期	前期	週時間数	2	
教科書/教材				
担当教員	中村 翼			

到達目標

- (1) 金属の電気的性質を説明し、移動度や導電率の計算ができる。
- (2) 真性半導体と不純物半導体を説明できる。
- (3) 半導体のエネルギー・バンド図を説明できる。
- (4) pn接合の構造を理解し、エネルギー・バンド図を用いてpn接合の電流-電圧特性を説明できる。
- (5) バイポーラトランジスタの構造を理解し、エネルギー・バンド図を用いてバイポーラトランジスタの静特性を説明できる。
- (6) 電界効果トランジスタの構造と動作を説明できる。
- (7) 電子回路の構成素子である、ダイオード、バイポーラトランジスタ、FETの特徴を説明でき、バイポーラトランジスタ、FETの等価回路を説明できる。
- (8) 利得、周波数帯域、インピーダンス整合等の増幅回路の基礎事項を説明できる。またトランジスタ増幅器のバイアス方法を説明できる。
- (9) 演算増幅器の特性を説明できる。また反転増幅器や非反転増幅器等の回路を説明できる。

ループリック

	理想的な到達レベルの目安	標準的な到達レベルの目安	未到達レベルの目安
評価項目1	金属の電気的性質を説明し、移動度や導電率の計算ができる。	金属の電気的性質を理解し、移動度や導電率の計算ができる。	金属の電気的性質を説明し、移動度や導電率の計算ができない。
評価項目2	真性半導体と不純物半導体を説明できる。	真性半導体と不純物半導体を理解できる。	真性半導体と不純物半導体を説明できない。
評価項目3	半導体のエネルギー・バンド図を説明できる。	半導体のエネルギー・バンド図を理解できる。	半導体のエネルギー・バンド図を説明できない。
評価項目4	pn接合の構造を理解し、エネルギー・バンド図を用いてpn接合の電流-電圧特性を説明できる。	pn接合の構造を理解し、エネルギー・バンド図を用いてpn接合の電流-電圧特性を理解できる。	pn接合の構造を理解し、エネルギー・バンド図を用いてpn接合の電流-電圧特性を説明できない。
評価項目5	バイポーラトランジスタの構造を理解し、エネルギー・バンド図を用いてバイポーラトランジスタの静特性を説明できる。	バイポーラトランジスタの構造を理解し、エネルギー・バンド図を用いてバイポーラトランジスタの静特性を理解できる。	バイポーラトランジスタの構造を理解し、エネルギー・バンド図を用いてバイポーラトランジスタの静特性を説明できない。
評価項目6	電界効果トランジスタの構造と動作を説明できる。	電界効果トランジスタの構造と動作を理解できる。	電界効果トランジスタの構造と動作を説明できない。
評価項目7	電子回路の構成素子である、ダイオード、バイポーラトランジスタ、FETの特徴を説明でき、バイポーラトランジスタ、FETの等価回路を説明できる。	電子回路の構成素子である、ダイオード、バイポーラトランジスタ、FETの特徴を理解でき、バイポーラトランジスタ、FETの等価回路を理解できる。	電子回路の構成素子である、ダイオード、バイポーラトランジスタ、FETの特徴を説明できない、バイポーラトランジスタ、FETの等価回路を説明できない。
評価項目8	利得、周波数帯域、インピーダンス整合等の増幅回路の基礎事項を説明できる。またトランジスタ増幅器のバイアス方法を説明できる。	利得、周波数帯域、インピーダンス整合等の増幅回路の基礎事項を理解できる。またトランジスタ増幅器のバイアス方法を理解できる。	利得、周波数帯域、インピーダンス整合等の増幅回路の基礎事項を説明できない。またトランジスタ増幅器のバイアス方法を説明できない。
評価項目9	演算増幅器の特性を説明できる。また反転増幅器や非反転増幅器等の回路を説明できる。	演算増幅器の特性を理解できる。また反転増幅器や非反転増幅器等の回路を理解できる。	演算増幅器の特性を説明できない。また反転増幅器や非反転増幅器等の回路を説明できない。

学科の到達目標項目との関係

本校 (1)-a 専攻科 (5)-a

教育方法等

概要	電子機器に必要不可欠である、電子回路および電子工学について、モデルコアカリキュラムの学習内容をベースに学修していく。また、実際の電子機器の回路構成についても考察を行う。
授業の進め方・方法	本講義は自主的に学ぶことを主体とし、基本的にゼミ形式で講義を進めていく。
注意点	(1) 提出物等の期限が守られなければ、減点の対象となる。 (2) 不明な点をそのままにせず、理解できない部分があれば必ず質問すること。 (3) 受講者の理解度によって、授業計画の内容(順番等)を見直す場合がある。

授業の属性・履修上の区分

アクティブラーニング ICT 利用 遠隔授業対応 実務経験のある教員による授業

授業計画

	週	授業内容	週ごとの到達目標
前期 1stQ	1週	導入／講義準備	本講義の進め方について理解し、次回の講義内容について、準備をすることができる。
	2週	金属	金属の電気的性質を説明し、移動度や導電率の計算ができる。
	3週	半導体1	真性半導体と不純物半導体を説明できる。
	4週	半導体2	半導体のエネルギー・バンド図を説明できる。
	5週	半導体デバイス1	pn接合の構造を理解し、エネルギー・バンド図を用いてpn接合の電流-電圧特性を説明できる。
	6週	半導体デバイス2	バイポーラトランジスタの構造を理解し、エネルギー・バンド図を用いてバイポーラトランジスタの静特性を説明できる。

	7週	半導体デバイス3	電界効果トランジスタの構造と動作を説明できる。
	8週	前期中間試験	
2ndQ	9週	電子回路の構成素子	電子回路の構成素子である、ダイオード、バイポーラトランジスタ、FETの特徴を説明でき、バイポーラトランジスタ、FETの等価回路を説明できる。
	10週	増幅回路	利得、周波数帯域、インピーダンス整合等の増幅回路の基礎事項を説明できる。またトランジスタ増幅器のバイアス方法を説明できる。
	11週	演算増幅器	演算増幅器の特性を説明できる。また反転増幅器や非反転増幅器等の回路を説明できる。
	12週	電子機器の回路構成を考察1	実際の電子機器をモデルとし、その内部回路の構成について、考察を行う。
	13週	電子機器の回路構成を考察2	実際の電子機器をモデルとし、その内部回路の構成について、考察を行う。
	14週	電子機器の回路構成を考察3	実際の電子機器をモデルとし、その内部回路の構成について、考察を行う。
	15週	これまでの復習	これまでに学修してきた内容の総復習を行う。
	16週	前期末試験	

評価割合

	試験（またはレポート）	発表	相互評価	態度（講義への関わり）	ポートフォリオ	その他	合計
総合評価割合	50	20	10	20	0	0	100
基礎的能力	0	0	0	0	0	0	0
専門的能力	50	20	10	20	0	0	100
分野横断的能力	0	0	0	0	0	0	0